PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-158187

(43)Date of publication of application: 15.06.1999

(51)Int.CI.

CO7F 7/08 B01J 23/20 B01J 31/02 B01J 31/02 B01J 31/12 C08G 77/08 C08G 77/20 // C07B 61/00

(21)Application number: 09-318003

(22)Date of filing:

19.11.1997

(71)Applicant: MITSUI CHEM INC

(72)Inventor: ISHIKAWA JUNICHI

INOUE KOJI IWATA KENJI ITO MASAYOSHI FUJIKAKE SHIRO

(30)Priority

Priority number: 09 92424

Priority date: 10.04.1997

Priority country: JP

09258973

24.09.1997

09260280 25.09.1997

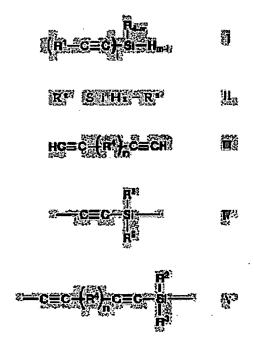
JP

JP

(54) PRODUCTION OF COMPOUND CONTAINING SILICON AND POLYMER-CONTAINING SILICON

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an industrially useful compound containing silicon and having acetylene bond, and polymer containing silicon simply by reacting a specific (hydro) silyl compound with a (di)ethynyl compound in the presence of metal compounds. SOLUTION: This compound containing silicon consisting of a silylacetylene compound expressed by formula I [(i) is ≤ m positive integer], is obtained by reacting a silyl compound expressed by the formula: R4-mSiHm [(m) is ≤4 positive integer, R is a 1-30C alkyl, an akenyl, an alkinyl, phenyl, naphthyl or the like] with an ethynyl compound expressed by the formula: R1-C≡CH (R1 is H or the same kind as R) in the presence of metal compounds. Further, a polymer containing silicon of formula IV or V is obtained by reacting a hydrosilyl compound expressed by formula II (R2, R3 are the same kind with R1) with a diethynyl compound xpressed by formula III [R4 is a 1-30C alkylene, phenylene or the like; (n) is 0, ≤4 positive integer] in the presence of metal



compounds.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

19.05.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出屬公開番号

特開平11-158187

(43)公開日 平成11年(1999)6月15日

(51) Int.Cl. ⁶ C 0 7 F 7/08 B 0 1 J 23/20 31/02	酸別配号 101 102	審査辦求	FI CO7E BO1		: :	C X 101X 102X X (全 21 頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号 (22) 出願日 (31) 優先権主張番号 (32) 優先日 (33) 優先権主張国 (31) 優先権主張国 (32) 優先日 (33) 優先権主張国 (31) 優先権主張国 (31) 優先権主張国	特願平9-318003 平成9年(1997)11月19日 特願平9-92424 平9(1997)4月10日 日本(JP) 特願平9-258973 平9(1997)9月24日 日本(JP) 特願平9-260280 平9(1997)9月25日		(71)出 (72)発 (72)発 (72)発	明明明明者者者者者	川淳一东川県横浜学株式会社上。 浩二 奈川県横浜 一株式会社 一条川県横浜 一条	区模が関三丁 市	目 2 番 5 号 1190 番地 三井 1190 番地 三井
(33)優先権主張国	日本(JP)						最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 含ケイ素化合物および含ケイ素ポリマーの製造方法

(57)【要約】

【課題】 含ケイ素化合物および含ケイ素ポリマーの製 造方法を提供する。

【解決手段】 金属化合物類を触媒として、〇シリル化 合物とエチニル化合物より一般式(1)

$$(H^{1}-C\equiv C)\frac{H_{4-m}}{Si-H_{m-1}} (1)$$

で表されるシリルアセチレン化合物、および②ヒドロシ リル化合物とジエチニル化合物より―般式(4)

$$-c \equiv c - (R^4)_n c \equiv c - \sum_{\substack{i \\ R^3}}^{R^2} (4)$$

で表される繰り返し単位を有する含ケイ素ポリマーを製 造する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 R_{4-a}-SiH_a(式中、mは4以下の正 の整数であり、Rは炭素数1から30のアルキル基、ア ルケニル基、アルキニル基、フェニル基やナフチル基な どの芳香族基でありハロゲン原子、水酸基、アミノ基、 カルボキシル基、エーテル基などの置換基を含んでいて もよい。mが1または2であるときRは各々が同じでも 異なっていてもよい。)で表されるシリル化合物とR¹ -C≡CH(式中、R¹は水素原子または炭素数1から 30のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、フェ ニル基やナフチル基などの芳香族基であり、ハロゲン原 子、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エーテル基な どの置換基を含んでいてもよい。)で表されるエチニル 化合物を金属化合物類の存在下に反応させることを特徴 とする-般式(1)(化1)

【化1】

$$(R^1-C\equiv C) = R_{4-m}$$
 (1)

(式中、mは4以下の正の整数であり、Rは炭素数1か 20 **ら30のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、フ** ェニル基やナフチル基などの芳香族基でありハロゲン原 子、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エーテル基な どの置換基を含んでいてもよい。mが1または2である ときRは各々が同じでも異なっていてもよい。R1は水 紫原子または炭素数 1 から 3 0 のアルキル基、アルケニ ル基、アルキニル基、フェニル基やナフチル基などの芳 香族基でありハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボ キシル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよ い。iはm以下の正の整数である。)で表されるシリル アセチレン化合物の製造方法。

【請求項2】 R'-SiH,-R'(式中、R'及びR' は互いに独立に、水素原子または炭素数1から30のア ルキル基、アルケニル基、アルキニル基、フェニル基や ナフチル基などの芳香族基であり、これらの基はハロゲ ン原子、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エーテル 基などの置換基を含んでいてもよい。)で表されるヒド ロシリル化合物とアセチレンまたは一般式(2)(化 2)

[(£2]

$$HC \equiv C - \left(R^4\right)_{\cap} C \equiv CH$$
 (2)

(式中、R⁴は炭素数1から30のアルキレン基、アル ケニレン基、アルキニレン基、フェニレン基やナフチレ ン基などの二価の芳香族基、芳香族基が直接または架橋 員により炭素数1から30のアルキレン基、アルケニレ ン基、アルキニレン基、芳香族基と連結した基であり、 とれらの基はハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボ キシル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよ い。nは0または4以下の正の整数である。)で表され 50 合を有する含ケイ索ボリマーの製造方法。

るジェチニル化合物を金属化合物類の存在下に反応させ ることを特徴とする一般式(3)(化3) [化3]

(式中、R'及びR'は互いに独立に、水素原子または炭 素数1から30のアルキル基、アルケニル基、アルキニ 10 ル基、フェニル基やナフチル基などの芳香族基であり、 とれらの基はハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボ キシル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよ い。) または一般式(4)(化4) [化4]

$$-c \equiv c - \left(R^4\right)_n c \equiv c - \begin{cases} R^2 \\ si - c \\ R^3 \end{cases}$$
 (4)

(式中、R'及びR'は互いに独立に、水素原子または炭 素数1から30のアルキル基、アルケニル基、アルキニ ル基、フェニル基やナフチル基などの芳香族基であり、 とれらの基はハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボ **キシル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよ** い。R1は炭素数1から30のアルキレン基、アルケニ レン基、アルキニレン基、フェニレン基やナフチレン基 などの二価の芳香族基、芳香族基が直接または架橋員に より炭素数 1 から30のアルキレン基、アルケニレン 基、アルキニレン基、芳香族基と連結した基であり、と れらの基はハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボキ シル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよい。 nは0または4以下の正の整数である。)で表される繰 り返し単位を含むアセチレン結合を有する含ケイ素ポリ マーの製造方法。

【請求項3】 請求項1において金属化合物類が有機金 属化合物類であることを特徴とする一般式(1)で表さ れるシリルアセチレン化合物の製造方法。

【請求項4】 請求項1において金属化合物類がアルコ キシド類であることを特徴とする一般式(1)で表され るシリルアセチレン化合物の製造方法。

【請求項5】 請求項1において金属化合物類が金属ア ミド類であることを特徴とする一般式(1)で表される シリルアセチレン化合物の製造方法。

【請求項6】 請求項2において金属化合物類が有機金 **斶化合物類であることを特徴とする―般式(3)または** 一般式(4)で表される繰り返し単位を含むアセチレン 結合を有する含ケイ素ポリマーの製造方法。

【請求項7】 請求項2において金属化合物類がアルコ キシド類であることを特徴とする一般式(3)または--般式(4)で表される繰り返し単位を含むアセチレン結

【請求項8】 請求項2において金属化合物類が金属ア ミド類であることを特徴とする一般式(3)または一般 式(4)で表される繰り返し単位を含むアセチレン結合 を有する含ケイ素ポリマーの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、シリル化合物とア セチレン化合物より金属化合物類を触媒として産業上有 用な含ケイ素化合物および含ケイ素ポリマーを製造する 新規な方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、シリル化合物とアセチレン化合物 よりアセチレン結合を有する含ケイ素化合物または含ケ イ素ポリマーを合成する方法としては、J. F. Harrodら の論文に記載されている塩化第一銅を触媒、アミン化合 物を助触媒とする方法(Hua Qin Liu and John F. Harr od, Canadian Journal of Chemistry, Vol. 68, 1100-1 105 (1990))、本発明者らが提案した塩基性金属酸化物 触媒を使用する方法(例えば特開平5-345825、 F. Harrodらの方法では助触媒であるアミン化合物の除 去が困難である。また塩基性金属酸化物触媒を使用する 方法では、金属水酸化物を高温で熱分解するなどの触媒 活性化の手間が必要であった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明者らは、前記課 題を解決するために鋭意検討した結果、金属化合物類を 触媒とすることによりシリル化合物とエチニル化合物よ りアセチレン結合を有する含ケイ素化合物が、またヒド ロシリル化合物とジエチニル化合物より含ケイ素ポリマ 一が簡便に得られることを見いだした。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、R -- - - S i H。(式中、mは4以下の正の整数であり、Rは炭素数 1から30のアルキル基、アルケニル基、アルキニル 基、フェニル基やナフチル基などの芳香族基でありハロ ゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エーテ ル基などの置換基を含んでいてもよい。mが1または2 であるときRは各々が同じでも異なっていてもよい。) で表されるシリル化合物とR¹-C≡CH(式中、R¹は 40 水素原子または炭素数1から30のアルキル基、アルケ ニル基、アルキニル基、フェニル基やナフチル基などの 芳香族基であり、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カ ルボキシル基、エーテル基などの置換基を含んでいても よい。)で表されるエチニル化合物を金属化合物類の存 在下に反応させることを特徴とする一般式(1)(化 5)

[0005]

[化5]

$$\begin{pmatrix}
A \\
H_{4-m} \\
Si - H_{m-l}
\end{pmatrix}$$
(1)

(式中、mは4以下の正の整数であり、Rは炭素数1か ら30のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、フ ェニル基やナフチル基などの芳香族基でありハロゲン原 子、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エーテル基な どの置換基を含んでいてもよい。mが1または2である ときRは各々が同じでも異なっていてもよい。R¹は水 10 素原子または炭素数1から30のアルキル基、アルケニ ル基、アルキニル基、フェニル基やナフチル基などの芳 香族基でありハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボ キシル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよ い。iはm以下の正の整数である。) で表されるシリル アセチレン化合物の製造方法である。

【0006】また、本発明はR'-SiH,-R'(式 中、R'及びR'は互いに独立に、水素原子または炭素数 1から30のアルキル基、アルケニル基、アルキニル 基、フェニル基やナフチル基などの芳香族基であり、こ 特願平4-240593)が知られている。しかし、J. 20 れらの基はハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボキ シル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよ い。)で表されるヒドロシリル化合物とアセチレンまた は一般式(2)(化6)

[0007]

[{k6}]

$$HC \equiv C - \left(H^4 \right)_0 C \equiv CH$$
 (2)

(式中、R*は炭素数1から30のアルキレン基、アル ケニレン基、アルキニレン基、フェニレン基やナフチレ ン基などの二価の芳香族基、芳香族基が直接または架橋 員により炭素数 1 から30のアルキレン基、アルケニレ ン基、アルキニレン基、芳香族基と連結した基であり、 これらの基はハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボ キシル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよ い。 nは0または4以下の正の整数である。) で表され るジエチニル化合物を金属化合物類の存在下に反応させ ることを特徴とする一般式(3)(化7)

[0008]

[{£7]

(式中、R'及びR'は互いに独立に、水素原子または炭 素数1から30のアルキル基、アルケニル基、アルキニ ル基、フェニル基やナフチル基などの芳香族基であり、 これらの基はハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボ キシル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよ い。) または一般式(4)(化8)

50 [0009]

$$-C \equiv C - \left(R^4\right)_n C \equiv C - \begin{bmatrix} R^2 \\ i \\ -Si \\ R^3 \end{bmatrix}$$
 (4)

(式中、R'及びR'は互いに独立に、水素原子または炭 素数1から30のアルキル基、アルケニル基、アルキニ ル基、フェニル基やナフチル基などの芳香族基であり、 これらの基はハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボ キシル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよ い。R*は炭素数1から30のアルキレン基、アルケニ レン基、アルキニレン基、フェニレン基やナフチレン基 などの二価の芳香族基、芳香族基が直接または架橋員に より炭素数1から30のアルキレン基、アルケニレン 基、アルキニレン基、芳香族基と連結した基であり、こ れらの基はハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボキ シル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよい。 nは0または4以下の正の整数である。) で表される繰 り返し単位を含むアセチレン結合を有する含ケイ素ポリ マーの製造方法である。

るシリル化合物とR¹--C≡CHで表されるエチニル化 合物を金属化合物類の存在下に反応させることを特徴と する一般式(1)で表されるシリルアセチレン化合物の 製造方法において金属化合物類が有機金属化合物類であ るととを特徴とする一般式(1)で表されるシリルアセ チレン化合物の製造方法である。また、本発明は、R --。-SiH。で表されるシリル化合物とR¹-C≡CH で表されるエチニル化合物を金属化合物類の存在下に反 応させることを特徴とする一般式 (1) で表されるシリ ルアセチレン化合物の製造方法において金属化合物類が アルコキシド類であることを特徴とする一般式(1)で 表されるシリルアセチレン化合物の製造方法である。ま た、本発明は、R.-。-SiH.で表されるシリル化合物 とR¹-C≡CHで表されるエチニル化合物を金属化合 物類の存在下に反応させることを特徴とする一般式

(1) で表されるシリルアセチレン化合物の製造方法に*

* おいて金属化合物類が金属アミド類であることを特徴と する一般式 (1) で表されるシリルアセチレン化合物の 製造方法である。

【0011】また、本発明はR'-SiH,-R'で表さ れるヒドロシリル化合物とアセチレンまたは一般式 (2) で表されるジェチニル化合物を金属化合物類の存 在下に反応させることを特徴とする一般式(3)または 一般式(4)で表される繰り返し単位を含むアセチレン 結合を有する含ケイ素ポリマーの製造方法において金属 10 化合物類が有機金属化合物類であることを特徴とする一 般式(3)または一般式(4)で表される繰り返し単位 を含むアセチレン結合を有する含ケイ素ポリマーの製造 方法である。また、本発明はR'-SiH,-R'で表さ れるヒドロシリル化合物とアセチレンまたは一般式

(2) で表されるジェチニル化合物を金属化合物類の存 在下に反応させることを特徴とする一般式(3)または 一般式(4)で表される繰り返し単位を含むアセチレン 結合を有する含ケイ素ポリマーの製造方法において金属 化合物類がアルコキシド類であることを特徴とする一般 20 式(3)または一般式(4)で表される繰り返し単位を 含むアセチレン結合を有する含ケイ素ポリマーの製造方 法である。また、本発明はR'-SiH,-R'で表され るヒドロシリル化合物とアセチレンまたは一般式(2) で表されるジエチニル化合物を金属化合物類の存在下に 反応させることを特徴とする一般式(3)または一般式 (4) で表される繰り返し単位を含むアセチレン結合を 有する含ケイ素ポリマーの製造方法において金属化合物 類が金属アミド類であることを特徴とする一般式(3) または一般式(4)で表される繰り返し単位を含むアセ 30 チレン結合を有する含ケイ素ポリマーの製造方法であ

[0012]

【発明の実施の形態】本発明の製造方法の特徴は、要約 すると、反応式(5)(化9)

[0013]

[{k9}

合物とR¹-C=CHで表されるエチニル化合物を金属 化合物類の存在下で脱水素反応させることにより、一般 式(1)で表されるシリルアセチレン化合物が製造でき※

※ることにある。

【0014】また、反応式(6)(化10)

[0015]

【化10】

で表されるように、R'-SiH,-R'で表されるヒド ロシリル化合物とアセチレンを金属化合物類の存在下で 50 単位を含むアセチレン結合を有する含ケイ素ポリマーが

反応させることにより一般式(3)で表される繰り返し

* [0017]

【0016】また、反応式(7)(化11)

式 (7) (化11) * [化11]
$$R^{2}-SiH_{2}-R^{3} + HC \equiv C - \left(R^{4}\right)_{\Pi}C \equiv CH \xrightarrow{\text{依如化介物剂}} -2H_{2}$$

$$-C \equiv C - \left(R^{4}\right)_{\Pi}C \equiv C - \stackrel{R^{2}}{Si} - \stackrel{(7)}{I}$$

で表されるように、R'-SiH,-R'で表されるヒドロシリル化合物と一般式(2)で表されるジエチニル化 10合物を金属化合物類の存在下で反応させることにより一般式(4)で表される繰り返し単位を含むアセチレン結合を有する含ケイ素ポリマーが製造できることにある。【0018】反応式(5)、反応式(6)、反応式

(7)で使用し得る金属化合物類とは金属原子に炭化水素基、アルコキシ基、アミノ基などが結合した化合物であり、これらの置換基の他に水素原子やハロゲン原子が金属と結合していてもよい。この金属化合物類は有機金属化合物類、金属アルコキシド類および金属アミド類に大別できる。

【0019】有機金属化合物類としてはアルキル基、アルキニル基、アルケニル基、アリール基などの炭化水素基が1種の金属と結合した有機金属および二種以上の金属と結合した複合有機金属などが挙げられる。金属元素としてはリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウムなどの1族典型元素、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウムなどの2族典型元素、ホウ素、アルミニウムなどの13族典型元素およびカドミニウム、亜鉛などの12族遷移金属元素などが挙げられる。

【0020】これらの金属元素に結合するアルキル基、 アルキニル、アルケニル、アリール基などの炭化水素基 としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロビ ル基、n-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、ベ ンチル基、シクロペンタジエニル基、ヘキシル基、シク ロヘキシル基、オクチル基、ピニル基、アリル基、1-プロペニル基、エチニル基、ヘキシニル基、フェニルエ チニル基、フェニル基、ナフチル基、ベンジル基、メチ ルベンジル基、トリル基、メシチル基、ジフェニルメチ ル基、トリフェニルメチル基、スチリル基、αーメチル ベンジル基などが挙げられる。 ただし、 金属の価数が2 以上である場合または複合有機金属ではこれらの有機基 の他にフルオロ基、クロロ基、ブロモ基、ヨード基など のハロゲン基、水素原子、メトキシ基やエトキシ基など のアルコキシ基またはアミノ基などが結合していてもよ 630

【0021】アルキル基、アルキニル、アルケニル、アリール基などの炭化水素基が金属と結合した有機金属化合物類としては、具体的には、メチルリチウム、エチルリチウム、プロビルリチウム、イソプロビルリチウム、

n ープチルリチウム、イソプチルリチウム、t ープチル リチウム、ベンチルリチウム、ヘキシルリチウム、シク ロヘキシルリチウム、オクチルリチウム、ビニルリチウ ム、アリルリチウム、1-プロペニルリチウム、エチニ ルリチウム、1 --ヘキシニルリチウム、フェニルリチウ ム、ナフチルリチウム、ベンジルリチウム、メチルベン ジルリチウム、トリルリチウム、メシチルリチウム、ジ フェニルメチルリチウム、トリフェニルメチルリチウ ム、スチリルリチウム、α-メチルベンジルリチウム、 フェニルエチニルリチウム、メチルナトリウム、エチル ナトリウム、ブロビルナトリウム、イソブロビルナトリ 20 ウム、n-ブチルナトリウム、イソブチルナトリウム、 t-ブチルナトリウム、ペンチルナトリウム、シクロペ ンタジエニルナトリウム、ヘキシルナトリウム、シクロ ヘキシルナトリウム、オクチルナトリウム、ピニルナト リウム、アリルナトリウム、1-プロペニルナトリウ ム、エチニルナトリウム、1-ヘキシニルナトリウム、 フェニルナトリウム、ナフチルナトリウム、ベンジルナ トリウム、メチルベンジルナトリウム、トリルナトリウ ム、メシチルナトリウム、ジフェニルメチルナトリウ ム、トリフェニルメチルナトリウム、スチリルナトリウ 30 Δ、αーメチルベンジルナトリウム、フェニルエチニル ナトリウム、メチルカリウム、エチルカリウム、プロビ ルカリウム、イソプロビルカリウム、n – プチルカリウ ム、イソプチルカリウム、モープチルカリウム、ペンチ ルカリウム、ヘキシルカリウム、シクロヘキシルカリウ ム、オクチルカリウム、ビニルカリウム、アリルカリウ ム、1-プロペニルカリウム、エチニルカリウム、1-ヘキシニルカリウム、フェニルカリウム、ナフチルカリ ウム、ベンジルカリウム、メチルベンジルカリウム、ト リルカリウム、メシチルカリウム、ジフェニルメチルカ リウム、トリフェニルメチルカリウム、スチリルカリウ ム、α-メチルベンジルカリウム、フェニルエチニルカ リウム、メチルルビジウム、エチルルビジウム、プロビ ルルビジウム、イソプロビルルビジウム、n ープチルル ビジウム、 t … ブチルルビジウム、フェニルルビジウ ム、メチルセシウム、エチルセシウム、プロピルセシウ ム、イソプロビルセシウム、n ープチルセシウム、t ー **ブチルセシウム、フェニルセシウム、ジメチルベリリウ** ム、ジェチルベリリウム、ジプロピルベリリウム、ジn **ープチルベリリウム、ジt-ブチルベリリウム、ジペン** 50 チルベリリウム、ジヘキシルベリリウム、ジフェニルベ リリウム、メチルベリリウムクロライド、エチルベリリ ウムクロライド、プロピルベリリウムクロライド、n-**プチルベリリウムクロライド、フェニルベリリウムクロ** ライド、メチルベリリウムプロマイド、エチルベリリウ ムプロマイド、プロピルベリリウムプロマイド、プチル ベリリウムプロマイド、フェニルベリリウムプロマイ ド、メチルベリリウムアイオダイド、エチルベリリウム アイオダイド、プロビルベリリウムアイオダイド、n-プチルベリリウムアイオダイド、フェニルベリリウムア イオダイド、ジメチルマグネシウム、ジエチルマグネシ 10 ウム、ジブロビルマグネシウム、ジn -- プチルマグネシ ウム、ジtーブチルマグネシウム、ジベンチルマグネシ ウム、ジヘキシルマグネシウム、ジフェニルマグネシウ ム、メチルマグネシウムフルオライド、エチルマグネシ ウムフルオライド、プロピルマグネシウムフルオライ ド、n -ブチルマグネシウムフルオライド、ヘキシルマ グネシウムフルオライド、フェニルマグネシウムフルオ ライド、メチルマグネシウムクロライド、エチルマグネ シウムクロライド、プロビルマグネシウムクロライド、 プチルマグネシウムクロライド、t-プチルマグネシウ 20 ン、トリプロビルボラン、トリn-プチルボラン、トリ ムクロライド、ペンチルマグネシウムクロライド、ヘキ シルマグネシウムクロライド、フェニルマグネシウムク ロライド、メチルマグネシウムブロマイド、エチルマグ ネシウムブロマイド、プロビルマグネシウムブロマイ ド、ブチルマグネシウムブロマイド、 t ープチルマグネ シウムプロマイド、ペンチルマグネシウムプロマイド、 ヘキシルマグネシウムプロマイド、フェニルマグネシウ ムプロマイド、メチルマグネシウムアイオダイド、エチ ルマグネシウムアイオダイド、プロビルマグネシウムア イオダイド、n-ブチルマグネシウムアイオダイド、ヘ 30 メチルアルミニウム、プロモジェチルアルミニウム、ブ キシルマグネシウムアイオダイド、フェニルマグネシウ ムアイオダイド、エチルマグネシウムハイドライド、エ **チルマグネシウムエトキシド、ジメチルカルシウム、ジ** エチルカルシウム、ジブロビルカルシウム、ジnープチ ルカルシウム、ジモープチルカルシウム、ジベンチルカ ルシウム、ジヘキシルカルシウム、ジフェニルカルシウ ム、メチルカルシウムクロライド、エチルカルシウムク ロライド、プロビルカルシウムクロライド、n-ブチル カルシウムクロライド、フェニルカルシウムクロライ ド、メチルカルシウムブロマイド、エチルカルシウムブ 40 ウムテトラブロビルアルミニウム、リチウムテトラヘキ ロマイド、プロピルカルシウムブロマイド、n-ブチル カルシウムプロマイド、フェニルカルシウムプロマイ ド、メチルカルシウムアイオダイド、エチルカルシウム アイオダイド、プロビルカルシウムアイオダイド、n --**プチルカルシウムアイオダイド、フェニルカルシウムア** イオダイド、ジメチルストロンチウム、ジエチルストロ ンチウム、ジプロピルストロンチウム、ジ**n -**プチルス トロンチウム、ジt…n…プチルストロンチウム、ジベ ンチルストロンチウム、ジヘキシルストロンチウム、ジ フェニルストロンチウム ジメチルバリウム、ジエチル 50 ル亜鉛、ナトリウムトリプロビル亜鉛、ナトリウムトリ

10 パリウム、ジプロピルバリウム、ジn ープチルバリウ **ム、ジt-n-プチルバリウム、ジベンチルパリウム、** ジヘキシルバリウム、ジフェニルバリウム、ジエチニル **パリウム、ジ (1-ヘキシニル) パリウム、ジ (フェニ** ル) パリウム、ジナフチルバリウム、ジベンジルバリウ ム、ジトリルバリウム、ジメシチルバリウム、ビス(ジ フェニルメチル)バリウム、ピス(トリフェニルメチ ル) パリウム、スチリル) パリウム、ジ (αーメチルベ ンジル) バリウム、ジ(フェニルエチニル)バリウム、 ジ(3ーエチニルフェニルエチニル)バリウム、ジ(4 ーエチニルフェニルエチニル) バリウム、エチルバリウ ムクロライド、エチルパリウムプロマイド、エチルパリ ウムアイオダイド、エチニルバリウムハイドライド、フ ェニルエチニルバリウムハイドライド、エチルバリウム エトキシド、プロピルバリウムプロボキシド、プチルバ リウムブトキシド、エチニルバリウムエトキシド、フェ ニルエチニルバリウムプロポキシド、フェニルエチニル パリウムプトキシド、エチルバリウムアミド、フェニル パリウムアミド、トリメチルボラン、トリエチルボラ t-n-ブチルボラン、トリペンチルボラン、トリヘキ シルボラン、トリフェニルボラン、トリメチルアルミニ ウム、トリエチルアルミニウム、トリプロピルアルミニ ウム、トリn-ブチルアルミニウム.トリt-n-ブチ ルアルミニウム、トリベンチルアルミニウム、トリヘキ シルアルミニウム、トリフェニルアルミニウム、クロロ ジメチルアルミニウム、クロロジエチルアルミニウム、 **クロロジプロビルアルミニウム、クロロジn-プチルア** ルミニウム、クロロジフェニルアルミニウム、プロモジ ロモジプロピルアルミニウム、プロモジn - プチルアル ミニウム、ブロモジフェニルアルミニウム、ジメチル亜 鉛、ジェチル亜鉛、ジプロビル亜鉛、ジューブチル亜 鉛、ジヘキシル亜鉛、ジフェニル亜鉛、ジメチルカドミ ウム、ジエチルカドミウム、ジブロピルカドミウム、ジ n ープチルカドミウム、ジヘキシルカドミウム、ジフェ ニルカドミウムなどが挙げられる。

【0022】また、有機金属化合物類の中で複合有機金 属としては、リチウムテトラエチルアルミニウム、リチ シニルアルミニウム、リチウムテトラ (フェニルエチニー ル) アルミニウム、リチウムトリ(フェニルエチニル) アルミニウムエトキシド、リチウムジ (フェニルエチニ ル) アルミニウムジエトキシド、ナトリウムテトラエチ ルアルミニウム、ナトリウムテトラプロピルアルミニウ ム、ナトリウムテトラヘキシニルアルミニウム、ナトリ ウムテトラ (フェニルエチニル) アルミニウム、リチウ ムトリエチル亜鉛、リチウムトリブロビル亜鉛、リチウ ムトリ (フェニルエチニル) 亜鉛、ナトリウムトリエチ

(フェニルエチニル) 亜鉛、カルシウムテトラエチル亜 鉛、カルシウムテトラプロビル亜鉛、ストロンチウムテ トラエチル亜鉛、ストロンチウムテトラプロビル亜鉛な どが挙げられる。

【0023】アルコキシド類としてはアルコキシ基と結 合する金属が一種である金属アルコキシド化合物および 二種であるヘテロ金属アルコキシド化合物に分けられ る。アルコキシ基が結合する金属元素としてはリチウ ム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウムなど の1族典型元素、ベリリウム、マグネシウム、カルシウ 10 ム、ストロンチウム、パリウムなどの2族典型元素、ホ ウ素、アルミニウム、ガリウム、インジウムなどの13 族典型元素、イットリウムなどの3族遷移金属元素、チ タン、ジルコニウムなどの4族遷移金属元素、ニオブな どの5族遷移金属元素、クロムなどの6族遷移金属元 素、マンガンなどの7族遷移金属元素、鉄などの8族遷 移金属元素、コパルトなどの9族遷移金属元素、ニッケ ルなどの10族遷移金属元素、銅などの11族遷移金属 元素および亜鉛などの12族遷移金属元素などが挙げら

【0024】これらの金属元素に結合するアルコキシ基 としてはメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソ プロポキシ基、n – ブトキシ基、イソブトキシ基、t – プトキシ基、ベンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、オ クチルオキシ基、アリルオキシ基、ベンジルオキシ基、 フェノキシ基、ナフチルオキシ基、メトキシエトキシ 基、メトキシエトキシエトキシ基、メトキシブロポキシ 基などが挙げられる。ただし、金属の価数が2以上であ る場合またはヘテロ金属アルコキシド化合物ではこれら のアルコキシ基の他にアルキル基、アルキニル基、アル 30 ケニル基、アリール基などの炭化水素基、フルオロ基、 クロロ基、ブロモ基、ヨード基などのハロゲン基、水素 原子またはアミノ基などが結合していてもよい。

【0025】アルコキシ基が1族典型金属元素と結合し た金属アルコキシド化合物としては、具体的には、リチ ウムメトキシド、リチウムエトキシド、リチウムプロポ キシド、リチウムイソプロポキシド、リチウム- n - ブ トキシド、リチウムイソプトキシド、リチウムーt-ブ トキシド、リチウムペンチルオキシド、リチウムヘキシ ルオキシド、リチウムオクチルオキシド、リチウムアリ ルオキシド、リチウムベンジルオキシド、リチウムフェ ノキシド、リチウムナフチルオキシド、リチウムメトキ シエトキシド、リチウムメトキシエトキシエトキシド、 リチウムメトキシプロポキシド、ナトリウムメトキシ ド、ナトリウムエトキシド、ナトリウムプロポキシド、 ナトリウムイソプロポキシド、ナトリウムーnープトキ シド、ナトリウムイソプトキシド、ナトリウムーt-ブ トキシド、ナトリウムペンチルオキシド、ナトリウムへ キシルオキシド、ナトリウムオクチルオキシド、ナトリ ウムアリルオキシド、ナトリウムベンジルオキシド、ナ 50 シウムジ(イソブトキシド)、カルシウムジ(1 - ブト

12

トリウムフェノキシド、ナトリウムナフチルオキシド、 ナトリウムメトキシエトキシド、ナトリウムメトキシエ トキシエトキシド、ナトリウムメトキシブロポキシド、 カリウムメトキシド、カリウムエトキシド、カリウムブ ロポキシド、カリウムイソプロポキシド、カリウム-n ープトキシド、カリウムイソブトキシド、カリウムー t --- ブトキシド、カリウムベンチルオキシド、カリウムへ **キシルオキシド、カリウムオクチルオキシド、カリウム** アリルオキシド、カリウムベンジルオキシド、カリウム フェノキシド、カリウムナフチルオキシド、カリウムメ トキシエトキシド、カリウムメトキシエトキシエトキシ ド、カリウムメトキシブロポキシド、ルビジウムメトキ シド、ルビジウムエトキシド、ルビジウムプロポキシ ド、ルビジウムイソプロポキシド、ルビジウム-n-ブ トキシド、ルビジウムーt-ブトキシド、ルビジウムベ ンジルオキシド、ルビジウムフェノキシド、ルビジウム メトキシエトキシド、セシウムメトキシド、セシウムエ トキシド、セシウムプロポキシド、セシウムイソプロポ キシド、セシウムーnーブトキシド、セシウムーt-ブ 20 トキシド、セシウムベンジルオキシド、セシウムフェノ キシド、セシウムメトキシエトキシドなどが挙げられ

【0026】アルコキシ基が2族典型金属元素と結合し た金属アルコキシド化合物としては、具体的には、ベリ リウムジ (メトキシド)、ベリリウムジ (エトキシ ド)、ベリリウムジ(プロポキシド)、ベリリウムジ (イソプロポキシド) 、ベリリウムジ(n -ブトキシ F) 、ベリリウムジ(イソプトキシド)、ベリリウムジ (t -- ブトキシド)、ベリリウムジ (ベンチルオキシ ド)、ベリリウムジ(ヘキシルオキシド)、ベリリウム ジ (オクチルオキシド)、ベリリウムジ (ベンジルオキ シド)、ベリリウムジ(フェノキシド)、ベリリウムジ (ナフチルオキシド)、ベリリウムジ (メトキシエトキ シド)、ベリリウムジ (メトキシエトキシエトキシ ド)、ベリリウムジ(メトキシブロボキシド)、マグネ シウムジ (メトキシド)、マグネシウムジ (エトキシ ド)、マグネシウムジ(プロポキシド)、マグネシウム ジ (イソブロポキシド)、マグネシウムジ(nープトキ シド)、マグネシウムジ(イソプトキシド)、マグネシ 40 ウムジ (t -- ブトキシド)、マグネシウムジ (ペンチル オキシド)、マグネシウムジ(ヘキシルオキシド)、マ グネシウムジ (オクチルオキシド)、マグネシウムジ (ベンジルオキシド)、マグネシウムジ(フェノキシ ド)、マグネシウムジ(メトキシエトキシド)、マグネ シウムジ (メトキシエトキシエトキシド)、マグネシウ ムジ (メトキシブロポキシド) 、マグネシウム、カルシ ウムジ (メトキシド) 、カルシウムジ (エトキシド) 、 カルシウムジ (プロポキシド)、カルシウムジ (イソブ ロポキシド)、カルシウムジ(n-ブトキシド)、カル キシド)、カルシウムジ(ペンチルオキシド)、カルシ ウムジ (ヘキシルオキシド) 、カルシウムジ(オクチル オキシド)、カルシウムジ(ベンジルオキシド)、カル シウムジ (フェノキシド) 、カルシウムジ (メトキシエ トキシド)、カルシウムジ(メトキシエトキシエトキシ ド)、カルシウムジ(メトキシブロポキシド)、ストロ ンチウムジ (メトキシド) 、ストロンチウムジ (エトキ シド)、ストロンチウムジ(プロポキシド)、ストロン チウムジ (イソプロポキシド) 、ストロンチウムジ(n ープトキシド)、ストロンチウムジ(イソプトキシ ド)、ストロンチウムジ(t ーブトキシド)、ストロン チウムジ (ベンチルオキシド) 、ストロンチウムジ(へ キシルオキシド)、ストロンチウムジ(オクチルオキシ ド)、ストロンチウムジ(ベンジルオキシド)、ストロ ンチウムジ (フェノキシド) 、ストロンチウムジ (メト キシエトキシド)、ストロンチウムジ(メトキシエトキ シエトキシド)、ストロンチウムジ(メトキシプロポキ シド)、パリウムジ(メトキシド)、パリウムジ(エト キシド)、バリウムジ(プロボキシド)、バリウムジ (イソプロポキシド) 、パリウムジ(n – プトキシ ド)、パリウムジ (イソブトキシド)、パリウムジ (s ---プトキシド)、バリウムジ(t -- プトキシド)、バリ ウムジ (ペンチルオキシド) 、パリウムジ(ヘキシルオ キシド)、バリウムジ(オクチルオキシド)、バリウム ジ (ベンジルオキシド) 、バリウムジ (フェノキシ ド)、バリウムジ(メトキシエトキシド)、バリウムジ (メトキシエトキシエトキシド)、パリウムジ (メトキ シプロポキシド) などが挙げられる。

【0027】アルコキシ基が13族典型金属元素と結合 した金属アルコキシド化合物としては、具体的には、ボ 30 ンテトラ(メトキシド)、チタンテトラ(エトキシ ロントリ (メトキシド) 、ボロントリ (エトキシド) . ボロントリ (プロポキシド)、ボロントリ (イソプロポ キシド)、ポロントリ (n -- ブトキシド)、ポロントリ (イソプトキシド)、ボロントリ(t ープトキシド)、 ボロントリ (ペンチルオキシド)、ボロントリ (ヘキシ ルオキシド)、ボロントリ(オクチルオキシド)、ボロ ントリ (ベンジルオキシド)、ボロントリ(フェノキシ F)、ボロントリ (メトキシエトキシド)、ボロントリ (メトキシエトキシエトキシド)、ボロントリ(メトキ シブロポキシド)、アルミニウムトリ(メトキシド)、 アルミニウムトリ (エトキシド)、アルミニウムトリ (プロポキシド)、アルミニウムトリ(イソプロポキシ ド)、アルミニウムトリ (n-ブトキシド)、アルミニ ウムトリ (イソプトキシド) 、アルミニウムトリ(t… プトキシド) 、アルミニウムトリ (ペンチルオキシ ド)、アルミニウムトリ(ヘキシルオキシド)、アルミ ニウムトリ(オクチルオキシド)、アルミニウムトリ (ベンジルオキシド)、アルミニウムトリ(フェノキシ F) 、アルミニウムトリ (メトキシエトキシド) 、アル ミニウムトリ(メトキシエトキシエトキシド)、アルミ 50 素と結合した金属アルコキシド化合物としては、具体的

14

ニウムトリ (メトキシプロポキシド) 、ガリウムトリ (メトキシド)、ガリウムトリ (エトキシド)、ガリウ ムトリ(プロポキシド)、ガリウムトリ(イソブロポキ シド)、ガリウムトリ(n-ブトキシド)、ガリウムト り (イソプトキシド) 、ガリウムトリ(t -プトキシ **ド)、ガリウムトリ(ペンチルオキシド)、ガリウムト** リ(ヘキシルオキシド)、ガリウムトリ(オクチルオキ シド)、ガリウムトリ(ベンジルオキシド)、ガリウム トリ(フェノキシド)、ガリウムトリ(メトキシエトキ 10 シド)、ガリウムトリ(メトキシエトキシエトキシ ド)、ガリウムトリ (メトキシプロポキシド)、インジ ウムトリ (メトキシド) 、インジウムトリ (エトキシ ド)、インジウムトリ(プロポキシド)、インジウムト リ(イソプロポキシド)、インジウムトリ(n-ブトキ シド)、インジウムトリ(イソプトキシド)、インジウ ムトリ(t-ブトキシド)、インジウムトリ(ペンチル オキシド)、インジウムトリ(ヘキシルオキシド)、イ ンジウムトリ(オクチルオキシド)、インジウムトリ (ベンジルオキシド)、インジウムトリ(フェノキシ 20 ド)、インジウムトリ(メトキシエトキシド)、インジ ウムトリ (メトキシエトキシエトキシド) 、インジウム トリ (メトキシブロポキシド) などが挙げられる。 【0028】アルコキシ基が3族遷移金属元素と結合し た金属アルコキシド化合物としては、具体的には、イッ トリウムトリ (エトキシド) 、イットリウムトリ(イソ プロポキシドシド)、イットリウムトリ(メトキシエト キシドシド) などが挙げられる。

【0029】アルコキシ基が4族遷移金属元素と結合し た金属アルコキシド化合物としては、具体的には、チタ ド)、チタンテトラ (プロポキシド)、チタンテトラ (イソプロポキシド) 、チタンテトラ (メトキシエトキ シド)、ジルコニウムテトラ(メトキシド)、ジルコニ ウムテトラ (エトキシド) 、ジルコニウムテトラ (プロ ポキシド)、ジルコニウムテトラ(イソプロポキシ ド)、ジルコニウムテトラ (メトキシエトキシド) など が挙げられる。

【0030】アルコキシ基が5族遷移金属元素と結合し た金属アルコキシド化合物としては、具体的には、ニオ 40 ブベンタ (エトキシド) などが挙げられる。アルコキシ 基が6族遷移金属元素と結合した金属アルコキシド化合 物としては、具体的には、クロムトリ(エトキシド)、 クロムトリ (イソプロポキシド) などが挙げられる。ア ルコキシ基が7族遷移金属元素と結合した金属アルコキ シド化合物としては、具体的には、マンガンジ(メトキ シド)、マンガンジ(エトキシド)などが挙げられる。 アルコキシ基が8族遷移金属元素と結合した金属アルコ キシド化合物としては、具体的には、鉄トリ(エトキシ ド)などが挙げられる。アルコキシ基が9族遷移金属元 には、コパルトジ (メトキシド) 、コパルトジ (エトキ シド) などが挙げられる。アルコキシ基が10族遷移金 属元素と結合した金属アルコキシド化合物としては、具 体的には、ニッケルジ (エトキシド) 、ニッケルジ (メ トキシド) などが挙げられる。アルコキシ基が11族遷 移金属元素と結合した金属アルコキシド化合物として は、具体的には、銅ジ(メトキシド)、鍋ジ(エトキシ ド)、銅ジ (プロポキシド)、銅ジ (イソプロポキシ ド) 、銅ジ (n - ブトキシド) 、銅ジ (t - ブトキシ ド)、銅ジ (メトキシエトキシド) などが挙げられる。 アルコキシ基が12族遷移金属元素と結合した金属アル コキシド化合物としては、具体的には、亜鉛ジエトキシ ド、亜鉛ジ (メトキシエトキシド) などが挙げられる。 【0031】ヘテロ金属アルコキシド化合物としては、 具体的には、リチウムアルミニウムテトラメトキシド、 リチウムアルミニウムテトラエトキシド、リチウムアル ミニウムテトラプロポキシド、ナトリウムアルミニウム テトラブトキシド、ナトリウムアルミニウムテトラメト 牛シド、ナトリウムアルミニウムテトラエトキシド、ナ トリウムアルミニウムテトラブロボキシド、ナトリウム 20 ソブロビルアミド、ナトリウムジイソブロビルアミド、 アルミニウムテトラブトキシド、カリウムアルミニウム テトラメトキシド、カリウムアルミニウムテトラエトキ シド、カリウムアルミニウムテトラプロボキシド、カリ ウムアルミニウムテトラブトキシドなどが挙げられる。 【0032】金属アミド類とは、本発明ではアンモニ ア、第1または第2アミンの水素原子1個が金属原子で 置換した金属アミド化合物;アンモニアまたは第1アミ ンの水素の原子2個が金属原子で置換した金属イミド化 合物;およびアンモニアの水素原子3個が金属原子で置 換した金属ニトリド化合物を意味する。

15

【0033】第1または第2アミンとしてはメチルアミ ン、ジメチルアミン、エチルアミン、エチルアミン、ブ ロビルアミン、ジプロピルアミン、イソプロピルアミ ン、ジイソプロピルアミン、プチルアミン、ジブチルア ミン、イソプチルアミン、ジイソプチルアミン、t-ブ **チルアミン、ジーt-ブチルアミン、ペンチルアミン、** ジペンチルアミン、ヘキシルアミン、ジヘキシルアミ ン、オクチルアミン、アリルアミン、ジアリルアミン、 トリメチルシリルアミン、ビス(トリメチルシリル)ア ミン、アニリン、ジフェニルアミンなどが挙げられる。 【0034】置換する金属元素としてはリチウム、ナト リウム、カリウム、ルビジウム、セシウムなどの 1 族典 型元素及びベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ス トロンチウム、バリウムなどの2族典型元素が挙げられ る。ただし、金属の価数が2以上である場合はこれらの 金属原子に水素原子またはフルオロ基、クロロ基、ブロ モ基、ヨード基などのハロゲン基、アルキル基、アルキ ニル基、アルケニル基、アリール基などの炭化水素基、 メトキシ基やエトキシ基などのアルコキシ基などが結合 していてもよい。

【0035】水素原子と置換する金属原子が1族典型金 属元素である金属アミド化合物としては、具体的には、 リチウムアミド、リチウムメチルアミド、リチウムジメ チルアミド、リチウムエチルアミド、リチウムジエチル アミド、リチウムブロビルアミド、リチウムジブロビル アミド、リチウムイソプロビルアミド、リチウムジイソ プロビルアミド、リチウムブチルアミド、リチウムジブ チルアミド、リチウムイソプチルアミド、リチウムジイ ソプチルアミド、リチウムーt-プチルアミド、リチウ 10 ムジーtープチルアミド、リチウムペンチルアミド、リ チウムジベンチルアミド、リチウムヘキシルアミド、リ チウムジヘキシルアミド、リチウムオクチルアミド、リ **チウムアリルアミド、リチウムジアリルアミド、リチウ** ムトリメチルシリルアミド、リチウムビス(トリメチル シリル) アミド、リチウムフェニルアミド、リチウムジ フェニルアミド、ナトリウムアミド、ナトリウムメチル アミド、ナトリウムジメチルアミド、ナトリウムエチル アミド、ナトリウムジエチルアミド、ナトリウムプロビ ルアミド、ナトリウムジブロピルアミド、ナトリウムイ ナトリウムブチルアミド、ナトリウムジブチルアミド、 ナトリウムイソブチルアミド、ナトリウムジイソブチル アミド、ナトリウムーtープチルアミド、ナトリウムジ ー 1 ープチルアミド、ナトリウムペンチルアミド、ナト りウムジベンチルアミド、ナトリウムヘキシルアミド、 ナトリウムジヘキシルアミド、ナトリウムオクチルアミ ド、ナトリウムアリルアミド、ナトリウムジアリルアミ ド、ナトリウムトリメチルシリルアミド、ナトリウムビ ス (トリメチルシリル) アミド、ナトリウムフェニルア 30 ミド、ナトリウムジフェニルアミド、カリウムアミド、 カリウムメチルアミド、カリウムジメチルアミド、カリ ウムエチルアミド、カリウムジエチルアミド、カリウム プロピルアミド、カリウムジプロピルアミド、カリウム イソプロピルアミド、カリウムジイソプロピルアミド、 カリウムブチルアミド、カリウムジブチルアミド、カリ ウムイソブチルアミド、カリウムジイソブチルアミド、 カリウムー t ープチルアミド、カリウムジー t ープチル アミド、カリウムペンチルアミド、カリウムジペンチル アミド、カリウムヘキシルアミド、カリウムジヘキシル 40 アミド、カリウムオクチルアミド、カリウムアリルアミ ド、カリウムジアリルアミド、カリウムトリメチルシリ ルアミド、カリウムビス(トリメチルシリル)アミド、 カリウムフェニルアミド、カリウムジフェニルアミド、 ルビジウムアミド、ルビジウムメチルアミド、ルビジウ ムジメチルアミド、ルビジウムエチルアミド、ルビジウ ムジエチルアミド、ルビジウムプロビルアミド、ルビジ ウムジブロビルアミド、ルビジウムイソブロビルアミ **ド、ルビジウムジイソプロビルアミド、ルビジウムブチ** ルアミド、ルビジウムジブチルアミド、ルビジウムイソ 50 プチルアミド、ルビジウムジイソプチルアミド、ルビジ

18

ウムジーt-ブチルアミド、ルビジウムジベンチルアミ ド、ルビジウムジヘキシルアミド、ルビジウムオクチル アミド、ルビジウムトリメチルシリルアミド、ルビジウ ムビス(トリメチルシリル)アミド、セシウムアミド、 セシウムメチルアミド、セシウムジメチルアミド、セシ ウムエチルアミド、セシウムジエチルアミド、セシウム プロビルアミド、セシウムジプロビルアミド、セシウム イソプロピルアミド、セシウムジイソプロピルアミド、 セシウムブチルアミド、セシウムジブチルアミド、セシ ウムイソブチルアミド、セシウムジイソプチルアミド、 セシウムジー t …ブチルアミド、セシウムジベンチルア ミド、セシウムジヘキシルアミド、セシウムオクチルア ミド、セシウムトリメチルシリルアミド、セシウムピス (トリメチルシリル) アミドなどが挙げられる。 [0036] 水素原子と置換する金属原子が2族典型金 属元素である金属アミド化合物としては、具体的には、 ベリリウムジアミド、ベリリウムビス(メチルアミ F)、ベリリウムビス(ジメチルアミド)、ベリリウム ピス (エチルアミド)、ベリリウムピス (ジエチルアミ F) 、ベリリウムピス(プロピルアミド)、ベリリウム ビス(ジプロビルアミド)、ベリリウムビス(イソプロ ビルアミド) 、ベリリウムビス(ジイソブロビルアミ ド)、ベリリウムピス (ブチルアミド)、ベリリウムビ ス (ジプチルアミド) 、ベリリウムピス (イソプチルア ミド)、ベリリウムピス(ジイソプチルアミド)、ベリ **リウムビス(t-ブチルアミド)、ベリリウムビス(ジ** - t - プチルアミド)、ベリリウムピス(ベンチルアミ ド)、ベリリウムビス(ジベンチルアミド)、ベリリウ ムビス(ヘキシルアミド)、ベリリウムビス(ジヘキシ ルアミド)、ベリリウムピス (オクチルアミド)、ベリ 30 ソブロピルアミド)、ストロンチウムピス (ブチルアミ リウムビス (アリルアミド)、ベリリウムビス (ジアリ ルアミド)、ベリリウムビス(トリメチルシリルアミ F)、ベリリウムビス(ビス(トリメチルシリル)アミ F)、ベリリウムピス(フェニルアミド)、ベリリウム ビス (ジフェニルアミド)、マグネシウムジアミド、マ グネシウムビス (メチルアミド) 、マグネシウムビス (ジメチルアミド)、マグネシウムビス (エチルアミ ド)、マグネシウムビス(ジエチルアミド)、マグネシ ウムビス (プロビルアミド)、マグネシウムビス (ジブ ロビルアミド)、マグネシウムビス(イソプロビルアミ 40 チウムビス(ジアリルアミド)、ストロンチウムビス ド)、マグネシウムピス(ジイソプロビルアミド)、マ グネシウムビス (プチルアミド)、マグネシウムビス (ジプチルアミド)、マグネシウムビス(イソブチルア ミド)、マグネシウムビス(ジイソブチルアミド)、マ グネシウムビス(t-プチルアミド)、マグネシウムビ ス (ジーt-プチルアミド) 、マグネシウムピス(ベン チルアミド)、マグネシウムピス (ジペンチルアミ F)、マグネシウムビス(ヘキシルアミド)、マグネシ ウムビス (ジヘキシルアミド)、マグネシウムビス (オ クチルアミド)、マグネシウムピス(アリルアミド)、

マグネシウムビス (ジアリルアミド) 、マグネシウムビ ス(トリメチルシリルアミド)、マグネシウムピス(ビ ス (トリメチルシリル) アミド) 、マグネシウムビス (フェニルアミド)、マグネシウムピス (ジフェニルア ミド)、カルシウムジアミド、カルシウムピス (メチル アミド)、カルシウムピス(ジメチルアミド)、カルシ ウムビス (エチルアミド)、カルシウムビス (ジエチル アミド)、カルシウムビス(プロピルアミド)、カルシ ウムビス(ジブロビルアミド)、カルシウムピス(イソ プロビルアミド)、カルシウムビス(ジイソプロビルア ミド)、カルシウムビス(ブチルアミド)、カルシウム ビス (ジブチルアミド)、カルシウムビス (イソブチル アミド)、カルシウムピス(ジイソブチルアミド)、カ ルシウムビス(t-プチルアミド)、カルシウムビス (ジーt-ブチルアミド)、カルシウムピス(ペンチル アミド)、カルシウムピス(ジベンチルアミド)、カル シウムビス (ヘキシルアミド)、カルシウムビス (ジヘ キシルアミド)、カルシウムビス(オクチルアミド)、 カルシウムピス(アリルアミド)、カルシウムビス(ジ 20 アリルアミド)、カルシウムピス(トリメチルシリルア ミド)、カルシウムビス (ピス (トリメチルシリル) ア ミド)、カルシウムビス(フェニルアミド)、カルシウ ムビス (ジフェニルアミド) 、ストロンチウムジアミ ド、ストロンチウムビス (メチルアミド)、ストロンチ ウムビス (ジメチルアミド) 、ストロンチウムビス (エ チルアミド)、ストロンチウムビス (ジエチルアミ ド)、ストロンチウムピス(プロピルアミド)、ストロ ンチウムビス(ジプロビルアミド)、ストロンチウムビ ス(イソプロピルアミド)、ストロンチウムピス(ジイ ド)、ストロンチウムピス(ジプチルアミド)、ストロ ンチウムビス (イソブチルアミド) 、ストロンチウムビ ス (ジイソブチルアミド)、ストロンチウムビス (t --プチルアミド)、ストロンチウムビス(ジー t ープチル アミド)、ストロンチウムビス (ベンチルアミド)、ス トロンチヴムピス (ジペンチルアミド) 、ストロンチウ ムビス (ヘキシルアミド) 、ストロンチウムビス (ジヘ キシルアミド)、ストロンチウムビス(オクチルアミ ド)、ストロンチウムビス(アリルアミド)、ストロン (トリメチルシリルアミド)、ストロンチウムピス(ビ ス (トリメチルシリル) アミド) 、ストロンチウムピス (フェニルアミド)、ストロンチウムビス(ジフェニル アミド)、バリウムジアミド、バリウムピス(メチルア ミド)、バリウムピス(ジメチルアミド)、バリウムビ ス (エチルアミド)、パリウムピス (ジエチルアミ ド)、バリウムビス (プロビルアミド)、バリウムビス (ジプロビルアミド)、バリウムビス(イソプロビルア ミド)、バリウムピス(ジイソプロピルアミド)、バリ 50 ウムビス (ブチルアミド)、バリウムビス (ジブチルア ミド)、パリウムピス (イソプチルアミド)、パリウム ビス(ジイソプチルアミド)、バリウムビス(t-プチ ルアミド) 、バリウムビス(ジー t -ブチルアミド)、 バリウムビス (ペンチルアミド) 、バリウムビス(ジベ ンチルアミド)、パリウムピス(ヘキシルアミド)、パ リウムビス (ジヘキシルアミド) 、バリウムビス(オク チルアミド)、バリウムピス(アリルアミド)、バリウ ムピス(ジアリルアミド)、パリウムピス(トリメチル シリルアミド)、バリウムビス(ビス(トリメチルシリ ル) アミド) 、パリウムピス (フェニルアミド) 、パリ 10 ウムビス (ジフェニルアミド) 、バリウム (ヒドロ) ア ミド、パリウム (ヒドロ) ジメチルアミドなどが挙げら れる。

【0037】水素原子と置換する金属原子が1族典型金 属元素である金属イミド化合物としては、具体的には、 リチウムイミド、リチウムメチルイミド、リチウムエチ ルイミド、リチウムプロビルイミド、リチウムイソプロ ビルイミド、リチウムプチルイミド、リチウムイソプチ ルイミド、リチウムーt-ブチルイミド、リチウムペン チルイミド、リチウムヘキシルイミド、リチウムオクチ 20 ムアリルイミド、カルシウムトリメチルシリルイミド、 ルイミド、リチウムアリルイミド、リチウムトリメチル シリルイミド、リチウムフェニルイミド、ナトリウムイ ミド、ナトリウムメチルイミド、ナトリウムエチルイミ ド、ナトリウムプロピルイミド、ナトリウムイソプロピ ルイミド、ナトリウムブチルイミド、ナトリウムイソブ チルイミド、ナトリウムー t ーブチルイミド、ナトリウ ムペンチルイミド、ナトリウムヘキシルイミド、ナトリ ウムオクチルイミド、ナトリウムアリルイミド、ナトリ ウムトリメチルシリルイミド、ナトリウムフェニルイミ ド、カリウムイミド、カリウムメチルイミド、カリウム 30 エチルイミド、カリウムプロピルイミド、カリウムイソ プロビルイミド、カリウムブチルイミド、カリウムイソ プチルイミド、カリウムー t ープチルイミド、カリウム ベンチルイミド、カリウムヘキシルイミド、カリウムオ クチルイミド、カリウムアリルイミド、カリウムトリメ チルシリルイミド、カリウムフェニルイミド、ルビジウ ムイミド、ルビジウムメチルイミド、ルビジウムエチル イミド、ルビジウムプロビルイミド、ルビジウムイソブ ロビルイミド、ルビジウムブチルイミド、ルビジウムイ ソブチルイミド、ルビジウムーtープチルイミド、ルビ 40 ウムニトリド、セシウムニトリド、ベリリウムニトリ ジウムトリメチルシリルイミド、セシウムイミド、セシ ウムメチルイミド、セシウムエチルイミド、セシウムブ ロビルイミド、セシウムイソプロピルイミド、セシウム プチルイミド、セシウムイソプチルイミド、セシウム… t-プチルイミド、セシウムトリメチルシリルイミドな どが挙げられる。

【0038】水素原子と置換する金属原子が2族典型金 属元素である金属イミド化合物としては、具体的には、 ベリリウムイミド、ベリリウムメチルイミド、ベリリウ ムエチルイミド、ベリリウムプロピルイミド、ベリリウ 50 化合物としては、具体的にはシラン、メチルシラン、ジ

20 ムイソプロビルイミド、ベリリウムプチルイミド、ベリ リウムイソプチルイミド、ベリリウムーt-プチルイミ ド、ベリリウムベンチルイミド、ベリリウムヘキシルイ ミド、ベリリウムオクチルイミド、ベリリウムアリルイ ミド、ベリリウムトリメチルシリルイミド、ベリリウム フェニルイミド、マグネシウムイミド、マグネシウムメ チルイミド、マグネシウムエチルイミド、マグネシウム プロピルイミド、マグネシウムイソプロピルイミド、マ グネシウムブチルイミド、マグネシウムイソブチルイミ ド、マグネシウムー t ープチルイミド、マグネシウムベ ンチルイミド、マグネシウムヘキシルイミド、マグネシ ウムオクチルイミド、マグネシウムアリルイミド、マグ ネシウムトリメチルシリルイミド、マグネシウムフェニ ルイミド、カルシウムイミド、カルシウムメチルイミ ド、カルシウムエチルイミド、カルシウムプロピルイミ **ド、カルシウムイソプロビルイミド、カルシウムプチル** イミド、カルシウムイソプチルイミド、カルシウム - t - プチルイミド、カルシウムペンチルイミド、カルシウ ムヘキシルイミド、カルシウムオクチルイミド、カルシ カルシウムフェニルイミド、ストロンチウムイミド、ス トロンチウムメチルイミド、ストロンチウムジメチルイ ミド、ストロンチウムエチルイミド、ストロンチウムブ ロビルイミド、ストロンチウムイソプロビルイミド、ス トロンチウムプチルイミド、ストロンチウムイソプチル イミド、ストロンチウム… t …ブチルイミド、ストロン チウムペンチルイミド、ストロンチウムヘキシルイミ ド、ストロンチウムオクチルイミド、ストロンチウムア リルイミド、ストロンチウムトリメチルシリルイミド、 ストロンチウムフェニルイミド、パリウムイミド、パリ ウムメチルイミド、バリウムエチルイミド、バリウムブ ロビルイミド、バリウムイソプロビルイミド、バリウム **プチルイミド、バリウムイソプチルイミド、バリウムー** t ープチルイミド、バリウムペンチルイミド、バリウム ヘキシルイミド、パリウムオクチルイミド、パリウムア リルイミド、パリウムトリメチルシリルイミド、パリウ ムフェニルイミドなどが挙げられる。

【0039】金属ニトリド化合物としてはリチウムニト リド、ナトリウムニトリド、カリウムニトリド、ルビジ ド、マグネシウムニトリド、カルシウムニトリド、スト ロンチウムニトリド、パリウムニトリドなどが挙げられ る。とれらの金属化合物類は単独であるいは二種以上を 混合して使用することができる。

R1-C=CHで表されるエチニル化合物を金属化合物 類の存在下で脱水素反応させることにより、一般式

(1) で表されるシリルアセチレン化合物を製造する方 メチルシラン、トリメチルシラン、エチルシラン、ジエ チルシラン、トリエチルシラン、フェニルシラン、ジフ ェニルシラン、トリフェニルシラン、ヘキシルシラン、 ビニルシラン、アリルシラン、エチニルシラン、2-ブ ロピニルシラン、ベンゾイルシラン、トリフルオロメチ ルシラン、(3,3,3-トリフルオロプロビル)シラ ン、4 - シリルトルエン、4 - シリルスチレン、4 - シ リルーα, α, αートリフルオロトルエン、メトキシシ ラン、ジメトキシラン、トリメトキシシラン、エトキシ

【0041】また、原料のR¹-C≡CHで表されるエ チニル化合物としては、具体的には、アセチレン、プロ ピン、1ープチン、1ーヘキシン、ピニルアセチレン、 ジアセチレン、フェニルアセチレン、エチニルシクロへ キサン、4-エチニルトルエン、4-エチニルアニリ ン、3-エチニルアニリンなどが挙げられる。

挙げられる。

【0042】本発明で得られる一般式(1)で表される シリルアセチレン化合物としては、具体的にはシリルア セチレン、ジエチニルシラン、メチルシリルアセチレ ン、ジメチルシリルアセチレン、トリメチルシリルアセ チレン、エチルシリルアセチレン、ジエチルシリルアセ チレン、トリエチルシリルアセチレン、フェニルシリル アセチレン、ジフェニルシリルアセチレン、トリフェニ ルシリルアセチレン、ヘキシルシリルアセチレン、ビニ ル (エチニル) シラン、アリル (エチニル) シラン、ジ エチニルシラン、2 - プロピニル (エチニル) シラン、 ベンゾイル (エチニル) シラン、トリフルオロメチル (エチニル) シラン、(3,3,3-トリフルオロプロビ ル)(エチニル)シラン、4-(エチニルシリル)トル 30 セチレン、ピス(フェニルエチニル)ジメチルシラン、 エン、4-(エチニルシリル)スチレン、4-(エチニ ルシリル) -α, α, α-トリフルオロトルエン、メト キシシリルアセチレン、ジメトキシシリルアセチレン、 トリメトキシシリルアセチレン、エトキシシリルアセチ レン、ジエトキシシリルアセチレン、トリエトキシシリ ルアセチレン、1-シリル-1-プロピン、ピス(1-プロビニル) シラン、メチルシリルー 1 - プロピン、ジ メチルシリルー 1 - プロピン、トリメチルシリルー 1 -プロビン、エチルシリルー 1 ープロピン、ジエチルシリ ルー1ープロピン、トリエチルシリルー1ープロピン、 フェニルシリルー1ープロピン、ジフェニルシリルー1 **ープロピン、トリフェニルシリルー l ープロピン、ヘキ** シルシリルー1-プロピン、1-シリルー1-ブチン、 ビス(1 -- プチニル)シラン、トリ(1 -- ブチニル)シ ラン、メチルシリルー1-プチン、ジメチルシリルー1 ープチン、トリメチルシリルー1-プチン、エチルシリ ルー1-ブチン、ジエチルシリル-1-ブチン、トリエ チルシリル・1ーブチン、フェニルシリルー1ーブチ ン、ジフェニルシリル-1-プチン、トリフェニルシリ ルー1-プチン、ヘキシルシリル-1-プチン、1-シ 50 シリル)トルエン、4-(フェニルエチニルシリル)ス

リルー 1 -ヘキシン、ピス(1 -ヘキセニル)シラン、 トリ(1-ヘキセニル)シラン、メチルシリルー1-ヘ キシン、ジメチルシリル…1…ヘキシン、トリメチルシ リルー1 -ヘキシン、エチルシリル-1-ヘキシン、ジ エチルシリルー1-ヘキシン、トリエチルシリルー1-ヘキシン、フェニルシリルー1 - ヘキシン、ジフェニル シリルー1ーヘキシン、トリフェニルシリルー1ーヘキ シン、ヘキシルシリルー1-ヘキシン、ピニルエチニル シラン、メチルシリル-2-プテン-1-イン、ジメチ シラン、ジエトキシシラン、トリエトキシシランなどが 10 ルシリルー2-ブテン-1-イン、トリメチルシリル-2 -- プテン-- 1 -- イン、エチルシリル-- 2 -- プテン-- 1 ーイン、ジエチルシリルー2-ブテン-1 -イン、トリ エチルシリル-2-ブテン-1-イン、フェニルシリル -2-ブテン-1-イン、ジフェニルシリル-2-ブテ ンー1-イン、トリフェニルシリル-2-ブテン-1-イン、ヘキシルシリルー2-プテン-1-イン、1-シ リルー1,3ープタジイン、メチルシリルー1,3ープタ ジイン、ジメチルシリルー1,3ープタジイン、トリメ チルシリルー1,3-ブタジイン、エチルシリルー1,3 20 ープタジイン、ジエチルシリルー1,3ープタジイン、 トリエチルシリルー1,3 ープタジイン、フェニルシリ ルー1,3ープタジイン、ジフェニルシリルー1,3ープ タジイン、トリフェニルシリル-1,3-ブタジイン、 ヘキシルシリルー1,3ープタジイン、フェニルエチニ ルシラン、ピス(フェニルエチニル)シラン、トリ(フ ェニルエチニル) シラン、テトラ (フェニルエチニル) シラン、メチルシリル(フェニル)アセチレン、ピス (フェニルエチニル) メチルシラン、トリ (フェニルエ チニル) メチルシラン、ジメチルシリル(フェニル)ア トリメチルシリル (フェニル) アセチレン、エチルシリ ル (フェニル) アセチレン、ビス (フェニルエチニル) エチルシラン、トリ (フェニルエチニル) エチルシラ ン、ジエチルシリル(フェニル)アセチレン、ビス(フ ェニルエチニル) ジエチルシラン、トリエチルシリル (フェニル) アセチレン、フェニルシリル(フェニル) アセチレン、ビス (フェニルエチニル) フェニルシラ ン、トリ(フェニルエチニル)フェニルシラン、ジフェ ニルシリル(フェニル)アセチレン、ピス(フェニルエ 40 チニル) ジフェニルシラン、トリフェニルシリル (フェ ニル) アセチレン、ヘキシルシリル(フェニル)アセチ レン、ピス (フェニルエチニル) ヘキシルシラン、トリ (フェニルエチニル) ヘキシルシラン、ピニル (フェニ ルエチニル)シラン、アリル(フェニルエチニル)シラ ン、フェニルエチニル(エチニル)シラン、2-プロピ ニル (フェニルエチニル) シラン、ベンゾイル(フェニ ルエチニル) シラン、トリフルオロメチル (フェニルエ チニル)シラン、(3,3,3--トリフルオロブロビル) (フェニルエチニル) シラン、4-(フェニルエチニル チレン、4 - (フェニルエチニルシリル) - α、α、α -- トリフルオロトルエン、メトキシシリル(フェニル) アセチレン、ジメトキシシリル(フェニル)アセチレ ン、トリメトキシシリル (フェニル) アセチレン、エト キシシリル(フェニル)アセチレン、ジエトキシシリル (フェニル) アセチレン、トリエトキシシリル(フェニ ル) アセチレン、シリルエン、3…シリルエチニルアニ リン、ピス(3-アミノフェニルエチニル)シラン3-(メチルシリルエチニル) アニリン、3 - (ジメチルシ リルエチニル) アニリン、3-(トリメチルシリルエチ 10 ニル) アニリン、3…(フェニルシリルエチニル)アニ リン、ピス(3-アミノフェニルエチニル)(フェニ ル) シラン、3-(ジフェニルシリルエチニル) アニリ ン、ビス(3-アミノフェニルエチニル)ジフェニルシ ラン、3- (トリフェニルシリルエチニル) アニリンな どが挙げられる。

【0043】反応装置は原料を供給する部分、反応容器 内部の攪拌装置、反応容器の温度を制御する部分などか **らなる。本反応は、無溶媒もしくは溶媒中で反応させる** るシリル化合物とR¹-C≡CHで表されるエチニル化 合物および触媒である金属化合物類、さらに必要に応じ て溶媒を仕込む。金属化合物類は溶液で、あるいは溶媒 に溶解することなくそのままの状態で仕込むことができ る。これらの容器への仕込の順序は特に限定するもので はない。反応溶液を所定の温度に制御しつつ、攪拌しな がら所定の時間反応させる。所定の反応時間後、蒸留ま たはカラム分離などの方法により、反応液より生成物を 分離精製する。

【0044】原料のR.-----SiH.で表されるシリル化 30 合物とR¹-C≡CHで表されるエチニル化合物の仕込 みの比率は特に限定するものではないが、好ましくはエ チニル化合物100mmolに対しlmmolから10 000mmolである。触媒である金属化合物類は単独 であるいは二種以上を混合して使用することができる。 触媒使用量はR¹-C≡CHで表されるエチニル化合物 100mmolに対し0.0001mmolから200 mmolである。

【0045】原料のR.--。-SiH.で表されるシリル化 合物またはR¹−C≡CHで表されるエチニル化合物が 気体の場合にはそのまま、あるいは高純度窒素、高純度 ヘリウム、高純度アルゴンなどの不活性ガスと混合後、 1~250kg/cm'Gの圧力で耐圧容器に圧入して 反応させることが望ましい。原料のシリル化合物および エチニル化合物がともに液体または固体の場合には反応 容器内は高純度窒素あるいは高純度ヘリウム、高純度ア ルゴンなどの不活性ガスで置換することが望ましい。シ リル化合物またはエチニル化合物の沸点が反応温度以下 の場合は不活性ガスの圧入などにより反応圧力を1~2 50kg/cm'Gに加圧し、原料の沸点を反応温度以

上にすることが好ましい。溶媒としては、ペンタン、ヘ キサン、ヘブタン、オクタンなどの飽和脂肪族系炭化水 素溶媒や、ペンゼン、トルエン、キシレン、エチルベン ゼン、メシチレンのような芳香族系炭化水素溶媒や、ジ エチルエーテル、n-ブチルエーテル、アニソール、ジ フェニルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、 ビス (2 -- メトキシエチル) エーテル、1, 2 -- ビス (2-メトキシエトキシ) エタンのようなエーテル系溶 媒や、ジクロロメタン、クロロホルムのような含ハロゲ ン溶媒や、Nーメチルピロリドン、ジメチルホルムアミ ド、シメチルアセトアミドのような有機極性溶媒及びと れらの混合溶媒が使用できる。溶媒の量は原料のR¹-C≡CHで表されるエチニル化合物1mmolに対して 0.1~40m1が好ましい。また、溶媒に含まれる水 分が触媒の活性を低下させる場合があるので、溶媒は予 め脱水乾燥したものを用いるのが好ましい。

【0046】反応温度は0~300℃、より好ましくは 20~150℃である。反応圧力は常圧、加圧のいづれ でもかまわないが、原料が常圧で気体または反応温度が ことができる。容器内に原料のR...-SiH.で表され 20 原料の常圧における沸点よりも高い場合には、耐圧の反 応容器を用いて加圧 (0~250kg/cm²・G) し、反応温度における原料の状態を液体にすることが望 ましい。反応時間は反応温度などにより異なるが0.1 ~200時間が適切である。

【0047】生成物の精製は、反応液に何も処理を施さ ない状態で行ってもかまわないが、反応液を水中に分散 させることにより触媒を分解分離した後で行うことが好 ましい。触媒を分解分離する水は酸性、中性のいずれで もかまわないがHF、HC1、HBr、H1、H₂S O4, HNO3, H2CO3, H3PO4, HCIO2, H ,S、H,SO,、H,S,O,などの無機酸またはHCOO H、CH,COOH、C,H,COOH、蓚酸などの有機 酸によりpHO~pH5の酸性状態にしたものが好まし い。水の量は触媒 1 mm o 1 に対し0. 4 m 1 ~ 4 0 0 m 1 である。無溶媒または水に対する溶解度が5 w t % 以上の反応溶媒を使用した場合は分散させる前に脱水乾 燥したベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族系炭 化水素溶媒を原料のR¹-C=CHで表されるエチニル 化合物 l m m o l に対し0. l m l ~ 4 0 m l 加えてお くととが好ましい。

[0048]次に、R'-SiH,-R'で表されるヒド ロシリル化合物とアセチレンまたは一般式(2)で表さ れるジエチニル化合物を金属化合物類の存在下で反応さ せることにより一般式(3)で表される繰り返し単位を 含むアセチレン結合を有する含ケイ素ポリマーを製造す る方法について説明する。本発明におけるR*-SiH, - R¹で表されるヒドロシリル化合物としてはシラン、 メチルシラン、ジメチルシラン、エチルシラン、ジエチ ルシラン、フェニルシラン、ジフェニルシラン、ヘキシ 50 ルシラン、ビニルシラン、アリルシラン、エチニルシラ

ン、1-シリル-2-プロピン、ベンゾイルシラン、ト リフルオロメチルシラン、1-シリル-3,3,3-トリ フルオロプロパン、4 ―シリルトルエン、4 ―シリルス チレン、4 -シリルエチニルトルエン、4 -シリル- α , α , α – トリフルオロトルエン、メトキシシラン、 ジメトキシシランシラン、エトキシシラン、ジエトキシ シランなどが挙げられる。

【0049】本発明で使用する一般式(2)で表される ジエチニル化合物としては、具体的にはジアセチレン、 m-ジエチニルベンゼン、p-ジエチニルベンゼン、o 10 --ジェチニルベンゼン、3,5 -- ジェチニルトルエン、 2,7-ジエチニルナフタレン、5,10-ジエチニルア ントラセン、4,4'ージエチニルピフェニル、ピス(4 -エチニルフェニル) メタン、2,2-ビス (p-エチ ニルフェニル) プロパン、2,2ーピス (p - エチニル フェニル) トリフルオロプロパン、ピス(4 - エチニル フェニル) エーテル、2,2-ピス (p-エチニルフェ ニル)スルフォン、2,6-ジエチニルビリジン、2,5 -ジェチニルチオフェン、化学式(8)(化12) [0050]

、化学式(12)(化16) [0054]

HC
$$\equiv$$
 C \rightarrow C \equiv CH (12)

40

等がある。

【0055】本発明で得られるアセチレン結合を有する 含ケイ素ポリマーは、具体的には繰り返し単位が化学式 (13) (化17)

[0056]

[{t17}

、化学式(14)(化18)

[0057]

【化18】

、化学式(15)(化19)

[0058]

[{£19}

※【化16】

-si-c≡c—

、化学式(16)(化20) [0059]

[化20]

、化学式(17)(化21)

[0060]

【化21】

、化学式(18)(化22)

[0061]

50 【化22】

*【化12】

、化学式(9)(化13)

[0051]

[化13]

、化学式(10)(化14)

[0052]

[化14]

、化学式(11)(化15)

[0053]

*20 【化15】

10

、シリレンエチニレン-1,3-フェニレンエチニレン (化学式(19))(化23)

[0062]

[化23]

、シリレンエチニレン-1,4-フェニレンエチニレン、 シリレンエチニレン-1,2-フェニレンエチニレン、フェニルシリレンエチニレン-1,3-フェニレンエチニレン (化学式(20))(化24)

[0063]

[化24]

、フェニルシリレンエチニレン-1,4-フェニレンエチニレン、フェニルシリレンエチニレン-1,2-フェニレンエチニレン、メチルシリレンエチニレン-1,3-フェニレンエチニレン(化学式(21))(化25)

[0064] [化25]

、ジフェニルシリレンエチニレン-1,3-フェニレンエ チニレン、メチルシリレンエチニレン-1,4-フェニレ ンエチニレン、メチルシリレンエチニレン-1,2-フェ ニレンエチニレン、化学式(22)(化26)

[0065]

[化26]

、ジメチルシリレンエチニレン-1,3-フェニレンエチニレン、化学式(23)(化27)

[0066]

(化27)

、化学式(24)(化28)

[0067] [(£28]

、化学式(25)(化29)

[0068]

【化29】

、化学式(26)(化30)

[0069]

【化301

20 、化学式(27)(化31)

[0070]

【化31】

、化学式(28)(化32)

[0071]

0 【化32】

、化学式(29)(化33)

[0072]

【化33】

40

、化学式(30)(化34)

[0073]

【化34】

50 、化学式(31)(化35)

[0074] [1235]

、化学式 (32) (化36)

[0075]

[化36]

、化学式(33)(化37)

[0076]

[{k37]

、化学式 (34) (化38)

[0077]

【化38】

、化学式(35)(化39)

[0078]

【化39】

$$-\underset{H}{\text{Si-C}} = C - \underbrace{\hspace{1cm}} - CH_2 - \underbrace{\hspace{1cm}} - C = C - \underbrace{\hspace{1cm}} (35)$$

、化学式(36)(化40)

[0079]

[(L40]

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
-SI-C \equiv C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
CH_3
\end{array}$$

$$C \equiv C$$

$$\begin{array}{c}
CH_3
\end{array}$$

$$C \equiv C$$

$$C = C$$

、化学式 (37) (化41)

[0080]

(化41)

、化学式 (38) (化42)

[0081]

[化42]

(16)

10

、化学式(39)(化43)

[0082]

[{£43]

20 、化学式(40)(化44)

[0083]

[1:44]

、化学式(41)(化45)

[0084]

【化45】

30

$$\bigcap_{S_i-C\equiv C} - C_S - C\equiv C - (41)$$

、化学式(42)(化46)

[0085]

[化46]

$$CH_3$$

$$-S_{i-}C \equiv C - CH_2 - C \equiv C - (42)$$
H

40 、化学式(43)(化47)

[0086]

[化47]

、化学式(44)(化48)

[0087]

[化48]

、化学式(45)(化49)

[0088]

(化49)

、化学式(46)(化50)

[0089] [化50]

、化学式 (47) (化51)

[0090]

【化51】

20

、化学式(5 1)(化5 5) 【0 0 9 4 】

 $\begin{array}{c} \times \\ -\text{Si-C} = \text{C} \\ -\text{N} \\ \text{O} \\ \text{O} \\ \text{CF}_3 \\ \text{O} \\ \text{CF}_3 \\ \text{O} \\ \text{O} \\ \text{C} = \text{C} \\ \text{C} = \text$

などである。

【0095】反応装置は原料を供給する部分、反応容器内部の摂拌装置、反応容器の温度を制御する部分などからなる。本反応は、無溶媒もしくは溶媒中で反応させることができる。容器内に原料のR²-SiH₂-R³で表されるヒドロシリル化合物とアセチレンまたは一般式

(2)で表されるジェチニル化合物および触媒である金 属化合物類、さらに必要に応じて溶媒を仕込む。金属化 合物類は溶液状態であるいはそのまま仕込むことができ る。これらの容器への仕込の順序は特に限定するもので はない。反応溶液を所定の温度に制御しつつ、攪拌しな がら所定の時間反応させる。所定の反応時間後、蒸留に 50 いが好ましくはジェチニル化名 10mmolから1000mm 金属化合物類は単独であるいに することができる。触媒使用量 チニル化合物100mmolが。

SI-C≣C NHCO C≣C (47)

、化学式(48)(化52)

[0091]

[化52]

、化学式(49)(化53)

[0092]

[化53]

、化学式(50)(化54)

[0093] [(£54]

※[化55]

よる原料および溶媒の除去、カラム分離もしくはポリマ 0 一の貧溶媒中に反応液を分散させるなどの方法により、 反応液よりポリマーを分離精製する。

【0096】原料のR²-SiH₂-R³で表されるヒドロシリル化合物とアセチレンまたは一般式(2)で表されるジエチニル化合物の比率は特に限定するものではないが好ましくはジエチニル化合物100mmolで対し10mmolから1000mmolである。触媒である金属化合物類は単独であるいは二種以上を混合して使用することができる。触媒使用量はアセチレンまたはジエチニル化合物100mmolである。

【0097】原料のアセチレンやR'-SiH,-R'で 表されるヒドロシリル化合物または一般式(2)で表さ れるジエチニル化合物が気体の場合にはそのまま、ある いは高純度窒素、高純度ヘリウム、高純度アルゴンなど のなどの不活性ガスと混合後、1~250kg/cm² Gの圧力で耐圧容器に圧入して反応させることが望まし い。原料のヒドロシリル化合物およびジエチニル化合物 がともに液体または固体の場合には反応容器内は高純度 窒素あるいは高純度ヘリウム、高純度アルゴンなどの不 活性ガスで置換することが望ましい。溶媒としては、ベ 10 ンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メシチ レンのような芳香族炭化水素系溶媒や、ジエチルエーテ ル、n-ブチルエーテル、アニソール、ジフェニルエー テル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ピス(2ーメ トキシエチル) エーテル、1,2-ピス(2-メトキシ エトキシ) エタンのようなエーテル系溶媒や、ジクロロ メタン、クロロホルムのような含ハロゲン溶媒や、Nー メチルピロリドン、ジメチルホルムアミド、ジメチルア セトアミドのような有機極性溶媒及びこれらの混合溶媒 が使用できる。溶媒の量は原料のジエチニル化合物 1 m 20 molに対して0.1~40mlが好ましい。また、溶 媒に含まれる水分が触媒の活性を低下させる場合がある ので、溶媒は予め脱水乾燥したものを用いるのが好まし

【0098】反応温度は0~300℃、より好ましくは20~150℃である。反応圧力は常圧、加圧のいづれでもかまわないが、原料が気体または反応温度が原料や溶媒の沸点よりも高い場合には耐圧の反応容器を用いて加圧(0~250kg/cm³・G)反応を行うことが望ましい。反応時間は反応温度などにより異なるが0.1~200時間が適切である。

【0099】生成物の精製は、反応液に何も処理を施さ ない状態で行ってもかまわないが、反応液を水中に分散 させることにより触媒を分解分離した後で行うことが好 ましい。触媒を分解分離する水は酸性、中性のいずれで もかまわないがHF、HC1、HBr、HI、H.S O. HNO, H.CO, H.PO, HClO, H 、S、H、SO、、H、S、O、などの無機酸またはHCOO H、CH, COOH、C。H, COOH、 蓚酸などの有機 酸によりpH0~pH5の酸性状態にしたものが好まし い。水の量は触媒1mmo1に対し0.4m1~400 m 1 である。無溶媒または水に対する溶解度が5 w t % 以上の反応溶媒を使用した場合は分散させる前に脱水乾 燥したベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族系炭 化水素溶媒を原料の一般式(2)で表されるジエチニル 化合物 1 m m o 1 に対し0. 1 m l ~ 4 0 m 1 加えてお くことが好ましい。

【0 1 0 0 】 ポリマーを析出分離する場合に使用できる ェニル)シラン(フェニルシラン仕込量に対する収率3 食溶媒にはペンタン、ヘキサン、ヘブタン、オクタンな 9%)およびピス(フェニルエチニル)(フェニル)シ どの脂肪族炭化水素やメタノール、エタノール、プロバ 50 ラン(フェニルシラン仕込置に対する収率1 9%)が得

ノールなどの脂肪族アルコールが挙げられる。貧溶媒の使用量は原料のアセチレンまたはジエチニル化合物1mmolに対して0.01~200ml、より好ましくは0.1~50mlである。

[0101]

【実施例】以下、本発明を実施例及び比較例によって説明する。

実施例1

100mlのガラス製容器の内部に磁気復拌子を設置し、容器内を商純度窒素ガスで置換した。続いて容器内に原料のフェニルシラン5.8g(54mmol)、フェニルアセチレン5.3g(52mmol)、溶媒のビス(2-メトキシエチル)エーテル10ml、触媒のローブチルリチウムへキサン溶液0.103g(nーブチルリチウム0.32mmol相当)を仕込み、80℃で20時間複拌を行った。反応後、反応液をGC(ガスクロマトグラフィー)で分析した。生成物としてフェニルエチニル(フェニル)シラン(収率44%)およびビス(フェニルエチニル)(フェニル)シラン(収率9%)が得られた。また、反応率はフェニルシラン62%、フェニルアセチレン77%であった。この結果より、金属化合物類を触媒とすることにより簡便にシリルアセチレン化合物が製造できることが示された。

[0102] 実施例2~6

触媒として表1に示す金属化合物類を使用し、その他の 条件は実施例1と同じにして8時間反応を行った。結果 を表1に示す。

【0103】実施例7~20

触媒として表2に示す金属化合物類を使用し、その他の 30 条件は実施例1と同じにして反応を行った。結果を表2 に示す。

【0104】実施例21

触媒としてリチウムビス(トリメチルシリル)アミド
1.04mol/lへキサン溶液0.30ml(0.3
1mmol)を用いその他の条件は実施例1と同じにして反応を行った。80℃で8時間撹拌を行った。生成物としてフェニルエチニル(フェニル)シラン(フェニルシラン仕込量に対する収率40%)およびビス(フェニルエチニル)(フェニル)シラン(フェニルシラン仕込量に対する収率13%)が得られた。また、反応率はフェニルシラン53%、フェニルアセチレン70%であった。

【0105】実施例22

触媒としてナトリウムピス(トリメチルシリル)アミド 1.0mo1/1THF溶液0.37m1(0.37mmo1)を使用し、その他の条件は実施例1と同様にして80℃で2時間機拌を行った。フェニルエチニル(フェニル)シラン(フェニルシラン仕込量に対する収率39%)およびピス(フェニルエチニル)(フェニル)シラン(フェニルシラン仕込量に対する収率19%)が得

られた。また、反応率はフェニルシラン68%、フェニルアセチレン94%であった。

【0106】実施例23

フェニルアセチレンの代わりにmージエチニルベンゼン6.7g(53mmol)を使用し、その他の条件は実施例1と同様にして80℃で20時間攪拌を行った。反応液をGCで分析したところフェニルシランの反応率は64%、mージエチニルベンゼンの反応率は76%であった。反応液に脱水トルエン20mlを加え、1規定塩酸水溶液20ml中に分散させた。有機相を1規定塩酸水溶液5mlで洗浄後、純水5mlづつで水相のpHが6になるまで洗浄した。CaSO、により脱水を行った後、5mmHgで50時間真空乾燥をおこない8.4gのポリマーを得た(収率67%)。GPC(ゲルバーミゼーションクロマトグラフィー)によるポリスチレン換算重量平均分子量は約2200であった。さらに分取用GPCカラムを用いて分子量で3600から1600の成分を分取しNMR、IR測定を行った。

 1 H-MMR(ppm,CDCl₃) 3.1(C≡C- \underline{H}). 4.7(Si \underline{H}). 5.1(S iH). 7.3 \sim 7.9(Ph- \underline{H}).

'3 C_NMR(ppm,CDCl₃) 78.1(-C≡ CH)、82.4(-C≡ CH)、8 6.5(Si-C≡ C-)、107.2(Si-C≡ C-)、122.7(Ph)、128.3~ 135.9(Ph)。

"Si-NMR(ppm,CDCl₃) -59.8(-<u>Si</u>H2-Ph), -63.5(><u>Si</u>H-Ph), -69.4(>Si<).

IR (cm⁻¹) 435, 476, 493, 602, 696, 73 6, 796, 845, 950, 1112, 1167, 1264, 1430, 1474, 15 92, 2156, 3069, 3291_a

NMR、1Rスペクトルからこのポリマーは特開平5 … 345825の実施例1で合成したポリマーと同じポリ 30 (フェニルシリレンエチニレンー1,3ーフェニレンエチニレン) であることを確認した。この結果より、金属化合物類を触媒とすることにより簡便にアセチレン結合を有する含ケイ素ポリマーが合成できることが示された。 【0107】実施例24

触媒としてバリウムジイソプロボキシド0.26mmo

1、ジエチニル化合物としてm-ジエチニルベンゼン 6.2g(49mmol)を使用し、その他の条件は実 施例23と同様にして80℃で3.75時間攪拌を行っ た。反応液をGCで分析したところフェニルシランの反 応率は90%、m-ジエチニルベンゼンの反応率は98 %であった。反応液に脱水テトラヒドロフラン60ml 及び脱水トルエン20mlを加え、1規定塩酸水溶液2 0ml中に分散させた。有機相を1規定塩酸水溶液5m 1で洗浄後、塩化ナトリウム13wt%水溶液5mlづ つで水相のpHが6になるまで洗浄した。CaSO。に より脱水を行った後、5mmHgで12時間真空乾燥を おこない9.8gの黄色ポリマーを得た(収率83 %)。GPC (ゲルパーミゼーションクロマトグラフィ 一) によるスチレン換算重量平均分子量は約53万であ った。またNMR、IRスペクトルは実施例23で合成 したポリマーと同じであった。

36

【0108】実施例25

触媒としてリチウムピス(トリメチルシリル)アミド 1.04m01/1ヘキサン溶液0.30m1(0.3 1 mm o 1)を用いその他の条件は実施例23と同様に して80°Cで8時間攪拌を行った。反応液をGCで分析 したととろフェニルシランの反応率は85%、血ージエ チニルベンゼンの反応率は78%であった。反応液に脱 水トルエン20mlを加え、1規定塩酸水溶液20ml 中に分散させた。有機相を1規定塩酸水溶液5m1で洗 浄後、塩化ナトリウム13w t %水溶液5 m l づつで水 相のpHが6になるまで洗浄した。CaSO、により脱 水を行った後、5mmHgで50時間真空乾燥をおこな い7.9gのポリマーを得た(収率68%)。GPC (ゲルバーミゼーションクロマトグラフィー) によるス チレン換算重量平均分子量は2400であった。さらに 分取用GPCカラムを用いて分子量で3600から16 00の成分を分取した。この成分のNMR、IRスペク トルは実施例23で合成したポリマーと同じであった。 [0109]

【表1】

37 **表1**

実施 例	触媒	転化率(%)		収率¹'(%)		
	金属化合物類	使用量(mmol)	フェニ ル シラン	フェニル アセチレン	AB ²⁾	AB, 8)
1	nープ チルリチウム	0.32	5 6	6 7	40	7
2	フェニルリチウム	0.34	5 1	63	4 5	10
3	シェン・チルマク・ネシウム	0.35	9	3	6	0
4	ジエチル亜鉛	0. 25	6	4	2	0.2
5	シクロペ"ンタシ" エニル ナトリウム	0. 29	1 2	7	9	0.3
6	プ [*] チルマク [*] ネシウム クロライト [*]	0.31	9	11	0.6	0

- 1)フェニルシラン仕込量に対する収率
- 2) AB: フェニルエチニル (フェニル) シラン
- 3) AB,: ピス (フェニルエチニル) (フェニル) シラン *20*【表2】

[0110]

表2

发	触媒	転化率(%)		収率1)(%)		
施例	金属化合物類	使用量(mmol)	フェニル ジラン	フェニル アセチレン	AB ²⁾	AB, 2)
7 8	パリウム シ゚イソプロポキシド	0. 26	7 2	97	44	2 5
	N* 110A5-71+51+	0. 27	74	98	49	24
10	ハ・リウム	0. 27	73	98	46	2 5
	ジーセープトキシド					
11	リチウムエトキシト*	0. 26	46	43	3 4	6
12	リチウムフェノキシト	0.32	2	0	0	0
13	ナトリウムエトキシト*	0.31	6 2	8 5	44	16
14	カリウムエトキシト	0.33	10	7	6	0.1
15	マクマネシウム	0. 29	2	3	0	0
	ジェトキシト	}				
16	カルシウムシ。エトキシト。	0. 27	0	0	0	0
17	ストロントウム	0. 28	3	0	0.7	0
	ジイソプロポキシド					
18	アルミニウム	0.26	7	2	0	0
	トリエトキシト			i		
19	カ"りりムトリエトキシト"	0.27	4	0	0	0
20	銅沙*ェトキシト*	0. 27	43	9 5	1	0.4

- 1)フェニルシラン仕込量に対する収率
- 2) AB: フェニルエチニル (フェニル) シラン
- 3) AB,: ピス (フェニルエチニル) (フェニル) シラン

シリル化合物とエチニル化合物からシリルアセチレン化 *ケイ素ポリマーを簡便に製造することができた。 合物を、ヒドロシリル化合物とジエチニル化合物より含*

-1 -1	٠,	L ~ 3	2の締き
- 7 U	_	ト・ヘー・コン	ノレンが常さ

FΙ 識別記号 (51) Int.Cl.6 C08G 77/08 C 0 8 G 77/08 77/20 77/20

300 C 0 7 B 61/00 300 // C O 7 B 61/00

(72)発明者 藤掛 史朗 (72)発明者 伊藤 正義

神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井 神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井

化学株式会社内 化学株式会社内